

15-11-12

고온 초전도체 관에서의 과도 자기확산 해석

Analysis of Transient Magnetic Diffusion in a High-Temperature Superconductor Tube

설승윤, 정성기

(S. Y. Seol and S. K. Jung)

Abstract

Transient magnetic diffusion process in a melt-cast BSCCO-2212 tube is analyzed by an analytical method. The transient diffusion partial differential equation is transformed into an ordinary differential equation by integral method. The penetration depth of magnetic field into a superconducting tube is obtained by solving the differential equation numerically. The results show that the penetration depth as a function of time which is somewhat different from the results by Bean's critical state model. The reason of the difference between the present results and that of Bean's model is discussed and compared in this paper.

Key Words : Analysis transient, Magnetic diffusion, High-Temperature Superconductor

1. 서론

임계온도 이하에서 제로저항이 되는 초전도체는 다양한 응용연구가 진행되고 있다[1,2]. 초전도체 한류기는 초전도 전력기기 중 활발히 연구되고 있는 분야중 하나이다[3]. 고온초전도 한류기는 유도형과 저항형으로 구분된다[4]. 유도형 한류기는 고온초전도체 튜브의 자기차폐효과를 이용하고 있다. 초전도 튜브 외부에 감겨있는 1차측 권선에 사고전류가 흐를 경우 초전도체 내부로 자기장이 침투해 들어가면서 큰 임피던스를 발생하여 사고전류를 제한하고 있다.

초전도체의 정상상태 자기침투를 해석할 때는 일반적으로 빈 임계상태모델(Bean's critical state model)을 사용한다. 빈(Bean) 모델은 자기 침투 시 초전도체 내부의 전류밀도가 임계전류밀도와 같다고 가정하고 있다. 그러나 교류전류나 주기적인 자기장의 변화에 의해 발생하는 비정상(transient) 자

기확산을 해석할 때는 사용할 수 없다[5-8].

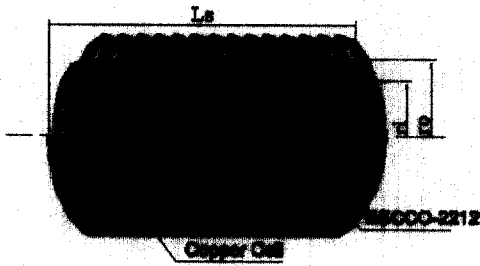
본 논문에서는 MCP(Melt Cast Process) 방법으로 제작한 BSCCO-2212 튜브를 대상으로 하여 외부자기장에 의해서 초전도체 내부에 비정상적으로 전파되는 자기확산 과정을 해석하고자 한다. 시간과 좌표에 대한 편미분 방정식으로 표현되는 자기확산 방정식을 적분하여 상미분 방정식으로 치환하고 이를 수치해석 하였다. 해석 결과인 시간에 따른 자기 침투깊이(penetration depth)를 빈(Bean) 모델에 의하여 구한 침투깊이와 비교하고 비정상상태에서의 자기확산은 정상상태에서의 침투깊이와 차이가 있음을 논하였다.

2. 해석

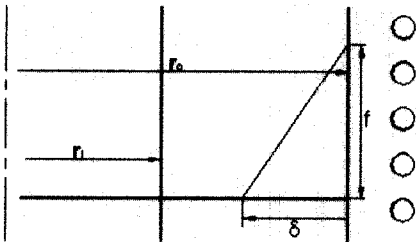
2.1 해석 모델

본 논문은 Y.S. Cha[7]의 초전도체 튜브 내의 비정상 자기확산 실험 결과를 이론적으로 해석하는데 있다. 그림 1(a)는 Y.S. Cha의 실험 개략도를 보여주고 있다. 초전도 튜브는 길이 L_s 는 74.8mm, 안쪽 반지름(r_i) 7.3mm, 외부 반지름(r_o) 12.8mm이다. 초전도체 튜브 외부에 지름 0.64mm인 22게이지 구리선을 1200턴(turn) 감아 외부에 자기장(f)을 주었다. 그림 1(b)는 외부 권선에 통전하여 튜브

전남대학교 기계공학과 1A-"설승윤"
(광주시 북구 용봉동 500-757)
Fax : 062-530-1689
E-mail : syseol@chonnam.chonnam.ac.kr
2002년 6월 7일 접수, 2002년 7월 4일 2차 심사완료
2002년 8월 5일 최종 심사완료



(a) 실제 모델



(b) 해석 모델

그림 1. 해석 모델의 개략도.

Fig. 1. Schematic of analysis model 외부에 자기장.

f 가 걸릴 시 초전도체 튜브 내부로 자기장이 깊이 δ 만큼 침투된 양상을 보이고 있다. 구리 코일의 안쪽 지름(r)은 26.8mm로 초전도체 튜브 바깥 지름보다 약간 크도록 제작되어 코일과 튜브 사이에 냉각제가 통과할 수 있도록 하였다. 이는 구리코일에서 발생하는 열이 초전도체 튜브에 영향을 주지 않도록 하기 위함이다. 초전도체 튜브와 구리코일은 액체 질소에 담겨져 있으므로, 액체 질소의 온도와 동일한 것으로 간주하였다.

이상은 Y.S. Cha의 실험 조건을 기술하였다. 본 논문에서는 위 실험에서 구한 결과들을 이론적으로 규명하기 위하여 자기 확산 방정식을 수치적으로 해석하였다. 원통좌표계에서 축 방향으로 작용하는 자기장(B)는 다음과 같은 편미분방정식으로 표현할 수 있다.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial B}{\partial r} \right) = \frac{\partial B}{\partial t} \quad (1)$$

초전도 튜브 내부에 형성되는 원주방향의 전류밀도(J)는 다음과 같이 식(2)으로 정의한다.

$$J = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial B}{\partial r} \quad (2)$$

여기서 B 는 초전도체 내부에 발생되어지는 자기장이고, μ_0 는 자유공간의 투자율이다. D 는 자기 확산계수를 의미하고 다음 식으로 정의된다.

$$D = \frac{\rho}{\mu_0} \quad (3)$$

ρ 는 전기 비저항이다.

초기에는 구리코일에 전류가 흐르지 않기 때문에 초전도 튜브 내부의 자기장은 제로이다.

$$B = 0, \quad t = 0 \quad r_i < r < r_o \quad (4)$$

구리코일에 전류가 흐르면 튜브 외부에는 코일에 의해 발생된 자기장이 인가되고 튜브 내부는 자기장의 구배가 제로인 조건이 된다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial B}{\partial r} &= 0, & r &= r_i \\ B &= f(t), & r &= r_o \end{aligned} \quad (5)$$

$f(t)$ 는 구리 코일에 의해 형성된 단위 길이당의 자기장을 의미한다.

$$f(t) = \alpha \mu_0 \frac{NI(t)}{L_c} \quad \text{at } r = r_o \quad (6)$$

여기서 L_c 는 코일의 길이이고, α 는 유한 길이 코일에 대한 보정 값이다. NI 은 구리선의 감긴수(N)에 통전된 전류(I)를 곱해준 값이다.

본 연구에서는 외부자기장이 시간에 따라 변화하는 경우, 즉 (6)식의 NI 값이 시간에 따라 변화하는 경우의 시간에 따른 튜브내의 자기장 침투 양상을 해석하였다.

2.2 전기 비저항

초전도체에서의 전기 비저항(이하 비저항) 값은 초전도체가 과도한 외부 자기하에 놓여 플럭스-크리프(flux creep)와 자속유동(flux flow)이 발생할 때 생기는 차폐 전류밀도(J)에 의해서 좌우된다. 실험을 통해서 구해진 BSCCO-2212의 E - J 특성 곡선에서 전기장(E)은 다음과 같은 식(7)의 값을 갖는다[5].

$$E = 3.2 \times 10^{-22} |J|^{7.356} \quad (7)$$

여기서 전류밀도(J)의 단위는 $[A/cm^2]$ 이고 E 의 단위는 $[\mu V \cdot cm]$ 이다.

초전도체의 비저항은 $\rho = dE/dJ$ 의 관계를 가지므로 식(7)의 E-J곡선을 미분하여 구할 수 있다.

$$\rho = 2.354 \times 10^{-21} |J|^{6.356} \quad (8)$$

식(8)의 비저항 ρ 의 단위는 $[\mu \Omega \cdot \text{cm}]$ 이다. 전기장 (E)이나 비저항(ρ)은 전류밀도(J)에 따라 그 값이 변한다.

2.3 지배방정식

원통좌표계에서의 자기확산 방정식 (1)을 r에 대하여 적분하면 다음과 같다.

$$\frac{d}{dt} \int_{r_0-\delta}^{r_0} r B dr = \left(r D \frac{dB}{dr} \right)_{r=r_0} - \left(r D \frac{dB}{dr} \right)_{r=r_0-\delta} \quad (9)$$

침투깊이 δ 는 튜브 바깥 면으로부터 측정된 것이다. 따라서 식(9)는 $r_0 - \delta < r < r_0$ 사이에 외부 자기장에 의한 자기침투가 일어나고 있고, $r_1 < r < r_0 - \delta$ 사이에는 아직 자기장이 침투하고 있지 않은 상황임을 의미한다.

자기장이 침투하지 못한 곳의 차폐전류는 제로이기 때문에 식(2)에 의하면 자기장의 구배 dB/dr 이 제로가 됨을 알 수 있다. 따라서 $r=r_0-\delta$ 에서의 $dB/dr=0$ 가 된다.

식(9)를 이용하여 자기 침투깊이를 구하기 위해서는 초전도 튜브 내부에 형성되는 자기장을 가정해야 한다. 이 방법은 점성유체 유동의 경계층 해석 방법과 유사하다. 초전도체 내부의 자기장 분포가 선형적으로 변화한다는 가정에 의하여 자기장의 분포를 다음식으로 나타낼 수 있다.

$$B = f(t) \cdot \left(\frac{r - (r_0 - \delta)}{\delta} \right) \quad (10)$$

선형 가정을 사용하면 B의 구배 dB/dr 는 $f(t)/\delta$ 가 된다. 전류밀도 J는 자기가 침투된 $r_0 - \delta < r < r_0$ 에서는 $J = -(1/\mu_0)(f(t)/\delta)$ 과 같은 일정한 상수값이 되고, 자기침투가 안된 $r_1 < r < r_0 - \delta$ 에서는 제로가 된다.

식(10)을 식(9)에 대입하여 정리하면 시간에 따른 침투깊이를 구할 수 있는 상미분방정식을 얻을 수 있다.

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{\frac{D}{r_0} \frac{f}{\delta} - \left(\frac{1}{2} \frac{\delta}{r_0} - \frac{1}{6} \frac{\delta^2}{r_0^2} \right) \frac{df}{dt}}{\left(\frac{1}{2} \frac{1}{r_0} - \frac{1}{3} \frac{\delta}{r_0^2} \right) f} \quad (11)$$

확산계수 D는 식(3)에 의하여, 그리고 비저항 ρ 는 식(8)에 의하여, 그리고 전류밀도 J는 식(2)에 의하여 구한다. 따라서 확산계수 D는 자기장의 구배 dB/dr 에 의하여 결정된다. $t=0$ 에서 $\delta=0$ 인 초기조건에서 식(11)의 미분방정식을 풀면 시간에 따른 침투깊이를 구할 수 있다.

초전도체 튜브 내부의 원주방향의 차폐전류 I_s 는 가로 단면적 $L\delta$ 에 전류밀도 J를 곱하여 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$I_s = L \int_{r_0-\delta}^{r_0} J dr = -aNI \quad (12)$$

즉 외부 자기장을 차폐하기 위하여 초전도체 내부에는 외부 코일에 흐르는 전류에 상당하는 전류가 반대방향으로 형성됨을 알 수 있다.

2.4 자화(Magnetization)

Bean의 임계상태 모델은 초전도체에 자기장이 침투되는 해당 부분에는 초전도체의 임계전류밀도가 흐른다고 가정하고 있다. 하지만 본 논문에서는 자기장의 확산을 맥스웰 방정식으로 구하고 자기확산 계수가 자기장 구배의 함수로 구해진다는 가정을 사용하고 있다.

자화(magnetization) M은 $-M = H - B_s/\mu_0$ 로 정의된다. H는 외부 솔레노이드에 의하여 가해지는 자장의 세기(magnetic intensity)로서 f/μ_0 의 값을 가진다. B_s 는 초전도체 내부의 자기장의 평균값이다.

$$B_s = \frac{1}{\pi(r_0^2 - r_1^2)} = \int_{r_1}^{r_0} B \cdot 2\pi r dr \quad (13)$$

식(10)과 같이 자기장이 분포되어 있다면 평균 자기장은 다음과 같다.

$$B_s = \frac{f}{3} \frac{\delta(3r_0 - \delta)}{r_0^2 - r_1^2} \quad (14)$$

따라서 자화(M)량은 다음과 같다.

$$-M = \frac{f}{\mu_0} \left(1 - \frac{1}{3} \frac{\delta(3r_0 - \delta)}{r_0^2 - r_1^2} \right) \quad (15)$$

위 식은 자기장의 침투가 튜브 안쪽 면까지 진행되기 전에만 적용할 수 있다.

본 논문에서는 식(11)의 상미분방정식을 풀이하여 침투깊이(δ)를 구한 후 초전도체 튜브내의 자화(M) 상태를 결정하였다. 하지만 빈(Bean) 모델은 침투깊이를 $\delta = f/(\mu_0 J_c)$ 으로 가정하므로 단지

외부자기장(J)에 의해서만 자화(M)를 결정할 수 있었다.

3. 결과 및 고찰

Y.S. Cha의 실험에서 코일 전류(I)는 pulse current source 의해 공급되어진다[7]. 이러한 코일 전류의 시간에 따른 변화율에 따라 침투시간도 달라진다. 전류가 시간에 따라 일정하게 증가하는 동안의 침투깊이 변화를 보기 위하여 NI 을 식(16)과 같이 근사하였다.

$$NI = st \tag{16}$$

t 는 시간이고 s 는 시간에 따라 변해지는 NI 의 기울기이다. 실험에 나타난 s 값은 400~6000(A/ms) 정도이다[7].

표 1은 각 s 값에 따라 계산된 결과들을 나타내었다. 침투시간 t_p 는 침투깊이가 튜브 안쪽 면에 이

표 1. s 에 따른 계산 결과.

Table 1. Results of calculation depending on s .

case	s (A/ms)	t_p (ms)	NI_{max} (A)	f_{max} (T)	J_{max} (A/cm ²)	$-M_{max}$ (A/m)
1	450	12.1	5445	0.097	1402.7	3.505e4
2	600	9.4	5640	0.101	1458.6	3.645e4
3	2500	2.7	6750	0.1203	1770.9	4.425e4
4	4000	1.8	7200	0.1283	1887.8	4.717e4

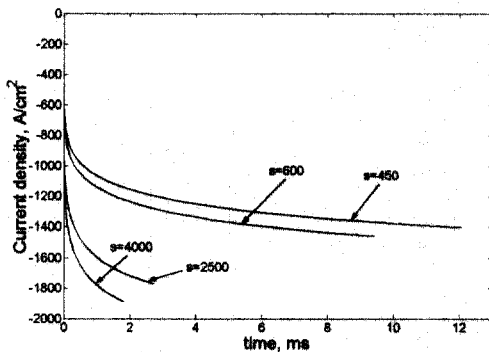


그림 2. NI 증가율에 의한 시간에 따른 전류밀도 변화.

Fig. 2. Current density vs. time for different increasing rates of NI .

른 시간을 말한다. NI_{max} , f_{max} , J_{max} , $-M_{max}$ 들은 시간 t_p 에서의 값들이다

Y.S. Cha에 의하면 실험에 사용된 BSCCO-2212의 임계전류밀도는 1785A/cm²이다[7]. 따라서 빈(Bean) 모델에 의하면 초전도체 내부의 자기장 구배는 22.4 T/m가 된다. 두께 5.5mm의 초전도체 튜브를 자기장이 완전 침투하는 경우의 외부 자기장의 세기는 0.123 T로써 NI 값 6900A에 해당한다. 즉, 빈 모델에 의하면 외부 코일에 흐르는 NI 값이 6900A에 이르면 시간에 관계없이 자기장이 튜브 전체에 침투되는 것으로 간주된다.

표 1에서 보여지는 case 1, 2, 그리고 3은 $NI=6900A$ 의 값을 초과하지 못하고 있으나 일정시간 뒤에 자기침투가 완결됨을 볼 수 있다. 즉 정상 상태만을 고려한 빈 모델에 의하면 자기침투가 완결되지 않으나, 외부 자기장이 시간에 따라 변화하는 경우는 자기침투가 튜브의 안쪽면까지 이를 수 있다.

그림 2는 본 수치해석을 통해서 구해진 전류증가율(s)의 값에 따른 초전도체의 전류밀도 값의 시간에 따른 변화이다. 전류증가율(s)에 따라 변하는 자기확산 모델에 의해 계산된 초전도체 내부의 전류밀도는 빈(Bean) 모델에 의하여 구한 값 1785A/cm²값과는 차이가 보이고 있다. 즉 빈(Bean) 모델에서는 초전도체 내부 전류밀도가 항상 일정하지만 자기확산 모델에 따르면 전류밀도는 시간에 따라 점차 증가하고 있다.

그림 3은 외부 권선에 흐르는 전류 증가율(s)에 따른 침투깊이 δ 의 시간에 따른 증가 양상을 나

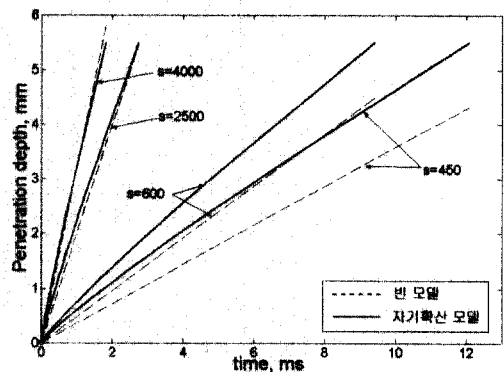


그림 3. NI 증가율에 의한 침투깊이의 시간에 따른 변화.

Fig. 3. Penetration depth vs. time for different increasing rates of NI .

4. 결론

초전도체(BSCCO-2212)튜브의 자화과정을 수치적으로 해석하였다. 비정상 자기확산 해석결과에 의해서 구해진 자기 침투깊이를 빈(Bean) 모델에 의해서 구한 침투깊이와 비교하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 비정상 자기확산 모델을 통해서 구해진 침투깊이와 자화량의 변화는 빈 모델에서 구한 침투깊이와 자화량의 변화와 차이가 있음을 확인하였다.
2. 외부 권선에서의 전류증가율이 적을 경우는 빈 모델과 자기확산모델의 차이가 큰 반면 전류증가율이 큰 경우는 두 모델의 차이가 감소한다.
3. 빈 모델을 통해서 구해진 자화량은 침투시간에 관계없이 침투된 범위 내에서 동일한 자화량을 갖는 반면에 자기확산 모델은 침투시간이 줄어들어 따라 상승한다.

이상의 결론에 의해 비정상적인 자기확산을 해석할 때 본 논문에서 사용한 자기확산 모델을 이용하면 정확한 해석을 할 수 있을 것으로 사료된다.

감사의 글

본 연구는 한국과학재단 목적기초연구(R01-2000-00308) 지원으로 수행되었음.

참고 문헌

- [1] S. S. Oh, K. S. Ryu, and S. H. Kim, "The recent trend of high- T_c superconductor", Trans. on EEM, Vol. 7, No. 3, p. 262, 1994.
- [2] G. E. Jang, J. K. You, H. J. Lee, and G. W. Hong, "Research and development of superconductor in the energy application area", Trans. on EEM, Vol. 9, No. 3, p. 310, 1996.
- [3] 송재우, 이재, 임성훈, 강형곤, 한병성, "고온 초전도체를 이용한 차폐유도형 전류저한기의 설계 및 동작 특성해석", 한국전기전자재료학회 2001하계학술대회논문집, 2권, 1호, p. 339, 2001.

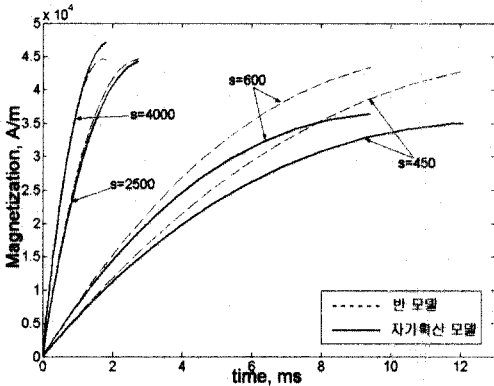


그림 4. NI 증가율에 의해 변하는 시간에 따른 자화.

Fig. 4. Magnetization vs. time for different rates of increasing NI.

타낸 수치해석 결과들이다. 점선은 빈 모델에 의한 침투깊이를 나타낸다. 빈 모델에서의 침투 깊이는 외부 자기장의 세기에 의해서만 결정되므로, 식(16)과 같이 선형으로 코일 전류가 변화하는 경우 침투깊이도 선형으로 증가한다.

자기확산 방정식에 의한 침투깊이는 시간에 따라 선형으로 변화하지 않고, 또한 빈 모델에 의한 침투깊이와도 차이를 보이고 있다. 이러한 차이는 s 값이 적을 경우 더 큰 차이를 보이는 반면, s가 증가함에 따라 빈 모델과의 차이가 줄어들어서, s=2500A/ms에서는 빈 모델의 침투깊이가 자기확산모델의 침투깊이에 근접하였다.

그림 4는 여러 가지 s 값에 대하여 초전도체의 자화량의 시간에 따른 변화를 보이고 있다. 실선은 본 논문의 자기 확산 모델에 따른 수치해석 결과이고 점선은 빈 모델에 따른 결과이다. s=450A/ms에 대한 결과를 보면 본 모델에서의 자화량이 빈 모델에 의한 자화량보다 적음을 볼 수 있다. 이는 빈 모델에서는 자기 침투 영역의 전류밀도가 임계 전류밀도라고 가정하는데 비해 본 모델에서는 표.1에서 보여지는 것처럼 s 값에 의해 변하는 전류밀도가 임계전류밀도 이하의 값으로 존재하여 빈(Bean)모델 보다 적은 자화량을 가지게 된다. 그러나 s=2500 A/ms에 대한 결과에서는 자기확산 모델과 빈 모델의 자화량이 거의 비슷하게 나온다. 이것은 빈 모델의 임계전류밀도에 근접한다는 것을 의미한다. 또한 자기확산 모델에 의하면 최종 자화량도 상승하는 반면에 빈(Bean) 모델의 경우 s값에 관계없이 최종 자화량은 동일하다.

- [4] 이찬주, 이승재, 강형구, 김태중, 현옥배, 고태국, "개방철심형 고온초전도체한류기의 동작 특성", 한국초전도·저온공학회논문지, 3권, 1호, p. 40, 2001.
- [5] Y. S. Cha and T. R. Askew, "Transient response of a superconductor tube to pulsed magnetic field", Physica C, Vol. 302, p. 57, 1998.
- [6] Y. S. cha, "Magnetic diffusion and dissipation in high- T_c superconductors subjected to sinusoidal applied fields", Physica C, Vol. 361, p. 1, 2001.
- [7] Y. S. Cha, "Magnetic diffusion in high- T_c superconductors", Physica C, Vol. 330, p. 1, 2000.
- [8] E. H. Brandt, "Superconductor disks and cylinders in an axial magnetic field. I. Flux penetration and magnetization curves", Phys. Rev. B, Vol. 58, No. 10, p. 6506, 1998-II.